

PNP MEDIUM POWER SILICON TRANSISTOR
Qualified per MIL-PRF-19500/561
Devices
2N6193
Qualified Level
**JAN, JANTX
JANTXV**
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N6193	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	5.0	Adc
Base Current	I_B	1.0	Adc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$	P_T	1.0	W
@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}^{(2)}$		10	W
Operating & Storage Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200	$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	17.5	$^{\circ}\text{C/W}$

1) Derate linearly 5.71mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > +25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 57.1mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > +25^{\circ}\text{C}$

**TO-39*
(TO-205AD)**

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Sustaining Voltage $I_C = 50 \text{ mAdc}$	$V_{CEO(sus)}$	100		Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 100 \text{ Vdc}$	I_{CEO}		100	μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 6.0 \text{ Vdc}$	I_{EBO}		100	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 90 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$	I_{CEX}		10	μAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$	I_{CBO}		10	μAdc

2N6193 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾

DC Current Gain I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 2.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc I _C = 5.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc	h _{FE}	60 60 40	240	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 2.0 Adc, I _B = 0.2 Adc I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc	V _{CE(sat)}		0.7 1.2	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 2.0 Adc, I _B = 0.2 Adc I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc	V _{BE(sat)}		1.2 1.8	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward-Current Transfer Ratio I _C = 0.5 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 10 MHz	h _{fe}	3.0	15	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		300	pF
Output Capacitance V _{BE} = 2.0 Vdc, I _C = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{ibo}		1250	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Delay Time	V _{CC} = -40 Vdc, V _{BE(off)} = 3.0 Vdc	t _d		100	ns
Rise Time	I _C = 2.0 Adc, I _{B1} = 0.2 Adc	t _r		100	ns
Storage Time	V _{CC} = -40 Vdc I _C = 2.0 Adc,	t _s		2.0	μs
Fall Time	I _{B1} = -I _{B2} = 0.2 Adc	t _f		200	ns

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C, 1 Cycle, t ≥ 0.5 s Test 1 V _{CE} = 2.0 Vdc, I _C = 5.0 Adc Test 2 V _{CE} = 90 Vdc, I _C = 55 mAdc					
--	--	--	--	--	--

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9